(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-275215 (P2002-275215A)

(43)公開日 平成14年9月25日(2002.9.25)

(51) Int.Cl.7	設別	記号 FI		7	·-マコート゚(参考)
C08F 2	20/28	C 0 8 F	20/28		2H025
G03F	7/039 6 0	1 G03F	7/039	601	4J100
H01L 2	21/027	H01L	21/30	502R	

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 23 頁)

(21)出願番号	特顧2001-368904(P2001-368904)	(71)出願人	000006035		
			三菱レイヨン株式会社		
(22)出顧日	平成13年12月3日(2001,12,3)		東京都港区港南一丁目 6 番41号		
		(72)発明者	加門 良啓		
Co. 4.3. Park May May 3 array and 100	*******	(12/76911			
(31)優先権主張番号	特願2001-1728 (P2001-1728)		広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨ		
(32)優先日	平成13年1月9日(2001.1.9)		ン株式会社中央技術研究所内		
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	藤原 国之		
			神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号 三		
			菱レイヨン株式会社化成品開発研究所内		
•	•	(74)代理人	100088328		
			弁理士 金田 暢之 (外2名)		
		1	EL 40 TS) ~ obs 2		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 重合体、化学増幅型レジスト組成物、および、パターン形成方法

(57)【要約】

【課題】 優れた透明性と高いドライエッチング耐性とを有し、有機溶媒に対する溶解性にも優れた重合体、遠紫外光エキシマレーザーリソグラフィーや電子線リソグラフィー等に好適な化学増幅型レジスト組成物、および、この化学増幅型レジスト組成物を用いたバターン形成方法を提供する。

【解決手段】 本発明の重合体は下記式(1)で示される単量体を含むモノマー組成物を(共)重合して得られるものであり、これを含有する化学増幅型レジスト組成物を用いてレジストバターンを形成する。

【化1】

(式(1)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 は水素原子、メチル基またはエチル基であり、 X^1 、 X^2 はいずれか一方が (メタ)アクリロイルオキシ基であり、もう一方が水素原子である。 A^1 、 A^2 はともに水素原子であるか、または、 A^1 と A^3 とで-O-、 $-CH_2$ -または $-CH_2$ CH $_2$ -を形成している。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(1)で示される単量体を含むモノマー組成物を(共)重合して得られる重合体。 【化1】

$$x^{1}$$
 A^{1}
 A^{2}
 A^{2}
 A^{2}
 A^{2}
 A^{3}
 A^{2}
 A^{3}
 A^{4}
 A^{3}
 A^{4}
 A^{3}
 A^{4}
 A^{3}
 A^{4}
 A^{4

* (式(1)中、R¹、R²、R³、R⁴は水素原子、メチル 基またはエチル基であり、X¹、X²はいずれか一方が (メタ)アクリロイルオキシ基であり、もう一方が水素原 子である。A¹、A²はともに水素原子であるか、また は、A²とA²とで-O-、-CH₂-または-CH₂CH 2-を形成している。)

【 請求項2 】 前記式(1)中のR¹、R²、R³、R ¹は、いずれか1つがメチル基であり、それ以外が水素原子である請求項1 に記載の重合体。

10 【請求項3】 下記式(2)で示される請求項1に記載の重合体。

(2)

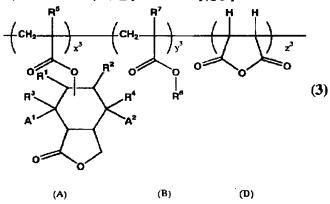
(式(2)中、R¹、R²、R³、R¹は水素原子、メチル基またはエチル基、R³、R²、R³は水素原子またはメチル基、R°は酸により脱離する基を有する環状炭化水素基、R°は親水性官能基を有する基または水素原子である。A¹とA²はともに水素原子であるか、または、A¹とA²とで-O-、 $-CH_2-$ または $-CH_2$ C H_2- を形成している。x²、y²、z²はそれぞれ構成単位(A)、構成単位(B)、構成単位(C)の比率を示し、x²+y²+z²=1のとき、 $0< x² \le 1$ 、 $0 \le y²$ ※

X < 1、 $0 \le z^2 < 1$ を満たす任意の数である。)

【請求項4】 前記式(2)中のR⁶が、シクロヘキシル基、イソボルニル基、アダマンチル基、トリシクロデカニル基、ジシクロペンタジエニル基、または、これら30 の環状炭化水素基上に置換基を有する環状炭化水素基のいずれか一種以上である請求項3に記載の重合体。

【請求項5】 下記式(3)で示される請求項1に記載の重合体。

【化3】



(式(3)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 は水素原子、メチル基またはエチル基、 R^3 、 R^3 は水素原子またはメチル基、 R^4 は酸により脱離する基を有する環状炭化水素基である。 A^4 と A^4 はともに水素原子であるか、または、

 $A^1 \& A^2 \& C^2 = O - (CH_1 - state - CH_2 CH_3 - state - CH_3 CH_3 - state - CH_3$

<1、0≤z³<1を満たす任意の数である。)

【請求項6】 前記式(3)中のR[®]が、シクロヘキシル基、イソボルニル基、アダマンチル基、トリシクロデカニル基、ジシクロペンタジエニル基、または、これらの環状炭化水素基上に置換基を有する環状炭化水素基の*

*いずれか一種以上である請求項5 に記載の重合体。 【請求項7】 下記式(4)で示される請求項1 に記載 の重合体。

[化4]

(式 (4) 中、R¹、R²、R³、R⁴、R¹°、R¹¹は水素原子、メチル基またはエチル基、R⁵、R²は水素原子またはメチル基、R⁵は酸により脱離する基を有する環状炭化水素基である。A¹とA²はともに水素原子であるか、または、A¹とA²とで-O-、 $-CH_2-$ または $-CH_2CH_2-$ を形成している。nは $0\sim 4$ の整数である。x⁴、y⁴、z⁴はそれぞれ構成単位(A)、構成単位(B)、構成単位(E)の比率を示し、x⁴+y⁴+z⁴=1のとき、0<x⁴ ≤ 1 、 $0\le$ y⁴< 1、 $0\le$ z⁴< 1 を満たす任意の数である。)

【請求項8】 前記式(4)中のR°が、シクロヘキシル基、イソボルニル基、アダマンチル基、トリシクロデカニル基、ジシクロペンタジエニル基、または、これらの環状炭化水素基上に置換基を有する環状炭化水素基のいずれか一種以上である請求項7に記載の重合体。

【請求項9】 質量平均分子量が1,000~100,000である請求項1~8のいずれかに記載の重合体。 【請求項10】 請求項1~9のいずれかに記載の重合体と、光酸発生剤とを含有する化学増幅型レジスト組成物。

【請求項11】 前記光酸発生剤の含有量が、前記重合体100質量部に対して0.1~20質量部である請求項10に記載の化学増幅型レジスト組成物。

【請求項12】 請求項10または11に記載の化学増幅型レジスト組成物を被加工基板上に塗布する工程と、250nm以下の波長の光で露光する工程と、現像を行う工程とを含むパターン形成法。

【請求項13】 露光に用いる250nm以下の波長の 光が、ArFエキシマレーザーである請求項12に記載 のパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レジスト用途等に 50 抑制基で保護したもの等が用いられる。しかし、ArF

有用な重合体、特に、エキシマレーザーあるいは電子線を使用する微細加工に好適なレジスト用重合体、およ び、この重合体を用いた化学増幅型レジスト組成物、パターン形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体素子あるいは液晶素子の製造における微細加工の分野においては、素子の高密度化、高集積化を実現するため、リソグラフィー技術の進歩を背景とした急速な微細化が進んでいる。その微細化の手法としては、一般に、露光光源の短波長化が用いられ、具体的には、従来のg線(波長:438nm)、i線(波長:365nm)に代表される紫外光から遠紫外光へと露光光源が変化してきている。

【0003】現在では、KrFエキシマレーザー(波長:248nm)リソグラフィー技術が市場に導入され、さらに短波長化を図ったArFエキシマレーザー(波長:193nm)リソグラフィー技術も導入されようとしている。さらに、次世代の技術として、F₂エキシマレーザー(波長:157nm)リソグラフィー技術が研究されている。また、これとは若干異なるタイプのリソグラフィー技術として、電子線リソグラフィー技術についても精力的に研究されている。

40 【0004】とのような短波長の光源あるいは電子線に対する高感度のレジストとして、インターナショナル・ビジネス・マシーン(IBM)社より「化学増幅型レジスト」が提唱され、現在、この化学増幅型レジストの改良および開発が精力的に進められている。

【0005】ところで、光源の短波長化においては、レジストに使用される樹脂もその構造変化を余儀なくされる。例えば、KrFエキシマレーザーリソグラフィーにおいては、波長248nmの光に対して透明性の高いポリヒドロキシスチレンや、その水酸基を酸解離性の溶解物制基で保護したもの等が用いたわる。

1

エキシマレーザーリソグラフィーにおいては、上記樹脂は波長193nmの光に対する透明性が必ずしも十分とはいえず、使用できない場合がある。

【0006】そのため、ArFエキシマレーザーリソグラフィーにおいて使用されるレジスト樹脂として、波長193nmの光に対して透明なアクリル系樹脂あるいはシクロオレフィン系樹脂が注目されている。とのようなアクリル系樹脂は特開平4-39665号公報、特開平10-207069号公報、特開平9-090637号公報等に開示されており、シクロオレフィン系樹脂は特間平10-153864号公報、特開平10-207070号公報等に開示されている。しかしながら、これらの樹脂を用いた場合においても、未だ性能的には十分とはいえず、より高いドライエッチング耐性が求められている。

【0007】波長193nmの光に対する透明性と高いドライエッチング耐性とを両立させる手段としては、例えば、5-(メタ)アクリロイルオキシ-6-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-カルボキシリック-6-ラクトン等を単量体単位として共重合させる 20方法が、特開2000-26446号公報に開示されている。

【0008】 このような共重合体は、レジスト用樹脂として優れた性能を発揮する。しかしながら、5-(メタ)アクリロイルオキシ-6-ヒドロキシビシクロ
[2.2.1] ヘブタン-2-カルボキシリック-6-ラクトンは常温で固体であり、有機溶媒に対する溶解性に劣っている。そのため、溶液重合で合成したレジスト用樹脂の再沈殿工程において、重合溶液中に残存する未反応の単量体を取り除くことが極めて困難であり、透過率を始めとするレジスト性能に悪影響が及ぶ場合もある。また、5-(メタ)アクリロイルオキシ-6-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-カルボキシリック-6-ラクトンを共重合させて得られるレジスト用樹脂も、通常、有機溶媒に対する溶解性に劣り、溶液重合を行ってレジスト用樹脂を得る際の条件が著しく制限される。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、優れた透明性と高いドライエッチング耐性とを有し、有機溶媒に対する溶解性にも優れた重合体、遠紫外光エキシマレーザーリソグラフィーや電子線リソグラフィー等に好適な化学増幅型レジスト組成物、および、この化学増幅型レジスト組成物を用いたバターン形成方法を提供することを

6

目的とする。

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 に鑑み、樹脂の構造について鋭意検討した結果、特定の 単量体単位を含む新規な重合体を用いることにより、遠 紫外光エキシマレーザーリソグラフィーや電子線リソグ ラフィー等に好適な化学増幅型レジスト組成物が得られ ることを見出し、本発明に至った。

【0011】すなわち、本発明の上記課題は、以下の本発明により解決できる。

【0012】**①**下記式(1)で示される単量体を含むモノマー組成物を(共)重合して得られる重合体。

[0013]

(化5)

(式(1)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 は水素原子、メチル基またはエチル基であり、 X^1 、 X^2 はいずれか一方が (メタ)アクリロイルオキシ基であり、もう一方が水素原子である。 A^1 、 A^2 はともに水素原子であるか、また は、 A^1 と A^2 とで-O-、 $-CH_2$ -または $-CH_2$ CH $_2$ -を形成している。)

【0014】**②**下記式(2)で示される前記**①**の重合体。

[0015]

[1k6]

(式(2)中、R¹、R²、R³、R⁴は水素原子、メチル基またはエチル基、R³、R²、R³は水素原子またはメチル基、R³は酸により脱離する基を有する環状炭化水素基、R³は親水性官能基を有する基または水素原子である。A¹とA²はともに水素原子であるか、または、A¹とA²とで-O-、 $-CH_2-$ または $-CH_2CH_2-$ を形成している。x²、y²、z²はそれぞれ構成単位(A)、構成単位(B)、構成単位(C)の比率を示し、x²+y²+z²=1のとき、 $0 < x² \le 1$ 、 $0 \le y² < 1$ 、 $0 \le z² < 1$ を満たす任意の数である。)【0016】なお、上記式(2)で示される重合体において、構成単位(A)、(B)、(C)は全て同じであ*

*る必要はなく、上記のような一般式で示されるものであれば構成単位(A)、(B)、(C)はそれぞれ2種以上が混在するものであってもよい。また、上記式(2)において、各構成単位は任意のシーケンスを取り得ることを意味する。したがって、上記式(2)で示される重合体は、ランダム共重合体であっても、ブロック共重合20体であってもよい。

【0017】**③**下記式(3)で示される前記**①**の重合体。

.【0018】 【化7】

(式(3)中、R¹、R²、R³、R¹は水素原子、メチル基またはエチル基、R⁵、R¹は水素原子またはメチル基、R⁵は酸により脱離する基を有する環状炭化水素基である。A¹とA²はともに水素原子であるか、または、A¹とA²とで-O-、 $-CH_1-$ または $-CH_1CH_2-$ を形成している。x³、y³、z³はそれぞれ構成単位(A)、構成単位(B)、構成単位(D)の比率を示し、x³+y³+z³=1のとき、 $0< x³\le 1$ 、 $0\le y³<1$ 、 $0\le z³<1$ を満たす任意の数である。)【0019】なお、上記式(3)で示される重合体において、構成単位(A)、(B)は全て同じである必要は

なく、上記のような一般式で示されるものであれば構成 単位(A)、(B)はそれぞれ2種以上が混在するもの 40 であってもよい。また、上記式(3)において、各構成 単位は任意のシーケンスを取り得ることを意味する。し たがって、上記式(3)で示される重合体は、ランダム 共重合体であっても、ブロック共重合体であってもよ い。

【0020】**②**下記式(4)で示される前記**①**の重合体。

[0021]

[化8]

9
$$\begin{pmatrix} CH_2 & R^5 \\ QH_2 & QH_2 \\ QH_1 & QH_2 \\ QH_2 & QH_2$$

(式(4)中、R¹、R²、R³、R⁴、R¹°、R¹¹は水素原子、メチル基またはエチル基、R⁵、R¹は水素原子またはメチル基、R°は酸により脱離する基を有する環状炭化水素基である。A¹とA²はともに水素原子であるか、または、A¹とA²とで-O-、-CH, -または-CH, -CH, -を形成している。nは0~4の整数である。x⁴、y⁴、z⁴はそれぞれ構成単位(A)、構成単位(B)、構成単位(E)の比率を示し、x⁴+y⁴+z⁴=1のとき、0 < x⁴ ≤ 1、0 ≤ y⁴ < 1、0 ≤ z⁴ < 1を満たす任意の数である。)

【0022】なお、上記式(4)で示される重合体において、構成単位(A)、(B)、(E)は全て同じである必要はなく、上記のような一般式で示されるものであれば構成単位(A)、(B)、(E)はそれぞれ2種以上が混在するものであってもよい。また、上記式(4)において、各構成単位は任意のシーケンスを取り得るととを意味する。したがって、上記式(4)で示される重合体は、ランダム共重合体であっても、ブロック共重合体であってもよい。

【0023】**⑤**質量平均分子量が1,000~100,000である前記**②~②**のいずれかの重合体。

【0024】**⑥**前記**①~⑤**のいずれかの重合体と、光酸発生剤とを含有する化学増幅型レジスト組成物。

【0025】の前記の化学増幅型レジスト組成物を被加工基板上に塗布する工程と、250nm以下の波長の光で露光する工程と、現像を行う工程とを含むパターン形成法。

【0026】なお、上記式(2)、(3)、(4)で示 40 される重合体の構成単位(A)において、主鎖に結合している基(不飽和結合が開鎖した(メタ)アクリロイルオキシ基)は、R¹またはR²が結合している炭素と結合している。

【0027】また、ここで「(共)重合」とは、常用されるように、単独重合または共重合を意味し、「(メタ)アクリロイル」とは、「アクリロイル」および「メタクリロイル」を意味する。

[0028]

【発明の実施の形態】本発明の重合体は、上記式(1)

で示される単量体を含むモノマー組成物を(共)重合して得られるものであり、上記式(1)で示される単量体の不飽和結合が開鎖(電子の移動)した単量体単位を含むものである。上記式(1)で示される単量体は、1種であっても、2種以上の混合物であってもよい。

【0029】上記式(1)で示される単量体は、縮合環または架橋環構造とヤーブチロラクトン構造とを同一分子内に有する。そのため、本発明の重合体は、遠紫外光に対する優れた透明性とともに、縮合環または架橋環構造に由来する、高いドライエッチング耐性と、露出したヤーブチロラクトン構造に由来する、優れた有機溶媒に対する溶解性とを有する。本発明の重合体は、特に、遠紫外光エキシマレーザーリソグラフィーや電子線リソグラフィー等に用いるレジスト樹脂として好適である。【0030】以下、本発明を詳しく説明する。

【0031】<u>1. 本発明の重合体に用いる単量体</u>まず、上記式(1)で示される単量体について説明する。

【0032】式(1)中、R¹、R²、R²、R¹は、それぞれ独立に、水素原子、メチル基またはエチル基であり、水素原子またはメチル基が好ましい。メチル基およびエチル基の個数は0~4つのいずれでもよいが、化学増幅型レジスト組成物用樹脂として用いる場合、0~2つ、特に0~1つが好ましい。

【0033】X¹、X²はいずれか一方が(メタ)アクリロイルオキシ基であり、もう一方が水素原子である。上記式(1)で示される単量体では、どちらが(メタ)アクリロイルオキシ基であってもかまわない。

【0034】 A^1 、 A^2 はともに水素原子であるか、または、 A^1 と A^2 とで-O-、 $-CH_1$ -または $-CH_2$ CH $_1$ -を形成している。中でも、優れたドライエッチング耐性が得られるので、 A^1 と A^2 とで-O-、 $-CH_1$ -または $-CH_1$ CH $_2$ -を形成していることが好ましく、特に A^1 と A^2 とで $-CH_2$ -を形成していることが好ましい。

【0035】とのような上記式(1)で示される単量体 として、具体的には、以下のものが例示できる。

50 【0036】7-アクリロイルオキシー3-オキサビシ

クロ[4.3.0]ノナン-2-オン、および、8-ア クリロイルオキシー3-オキサビシクロ[4.3.0] ノナンー2ーオン、ならびに、これらの混合物、

【0037】7-アクリロイルオキシ-7-メチル-3 -オキサビシクロ[4.3.0] ノナン-2-オン、7 -アクリロイルオキシ-8-メチル-3-オキサビシク ロ[4.3.0] ノナン-2-オン、8-アクリロイル オキシー7-メチルー3-オキサビシクロ「4.3. 0] ノナン-2-オン、および、8-アクリロイルオキ シー8-メチル-3-オキサビシクロ[4.3.0]ノ 10 ン、8-アクリロイルオキシ-9-エチル-4-オキサ ナンー2ーオン、ならびに、これらの混合物、

【0038】7-アクリロイルオキシー6-メチル-3 ーオキザビシクロ[4.3.0]ノナン-2ーオン、7 -アクリロイルオキシ-9-メチル-3-オキサビシク ロ[4.3.0] ノナン-2-オン、8-アクリロイル オキシー6-メチルー3-オキサビシクロ[4.3. 0] ノナン-2-オン、および、8-アクリロイルオキ シーターメチルー3ーオキサビシクロ「4.3.0]ノ ナンー2ーオン、ならびに、これらの混合物、

【0039】7、8-ジメチル-7-アクリロイルオキ 20 シー3ーオキサビシクロ[4.3.0]ノナン-2-オ ン、および、7、8-ジメチル-8-アクリロイルオキ シ-3-オキサビシクロ[4.3.0]ノナン-2-オ ン、ならびに、これらの混合物、

【0040】8-アクリロイルオキシ-4-オキサトリ シクロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オン、およ び、9-アクリロイルオキシ-4-オキサトリシクロ $[5.2.1.0^{2.6}]$ \vec{r} \vec{n} $\vec{n$ これらの混合物、

-オキサトリシクロ [5. 2. 1. 0^{2.6}] デカン-3 -オン、8-アクリロイルオキシ-8-メチル-4-オ キサトリシクロ [5.2.1.01.6] デカンー3ーオ ン、8-アクリロイルオキシ-9-メチル-4-オキサ トリシクロ $[5.2.1.0^{2.6}]$ デカン-3-オン、 8-アクリロイルオキシ-1-メチル-4-オキサトリ シクロ[5.2.1.0^{2,6}] デカン-3-オン、8-アクリロイルオキシー10-メチル-4-オキサトリシ クロ[5.2.1.011] デカン-3-オン、9-ア クリロイルオキシー7-メチルー4-オキサトリシクロ 40 ロ[5.2.1.01.6] デカン-3-オン、ならび $[5, 2, 1, 0^{2,6}]$ \vec{r} \vec{n} \vec{n} ロイルオキシー8-メチル-4-オキサトリシクロ $[5, 2, 1, 0^{2,6}]$ \vec{r} \vec{n} \vec{n} ロイルオキシーターメチルー4ーオキサトリシクロ [5.2.1.0².⁶] デカン-3-オン、9-アクリ ロイルオキシー1-メチル-4-オキサトリシクロ [5, 2, 1, 0^{2,6}] デカン-3-オン、および、9 -アクリロイルオキシ-10-メチル-4-オキサトリ シクロ[5, 2, 1, 02,6] デカン-3-オン、なら びに、これらの混合物、

【0042】8-アクリロイルオキシ-4-オキサトリ シクロ[5.2.2.02.6] ウンデカン-3-オン、 および、9-アクリロイルオキシ-4-オキサトリシク ロ[5.2.2.01.6] ウンデカン-3-オン、なら びに、これらの混合物、

【0043】8-アクリロイルオキシ-7-エチル-4 -オキサトリシクロ[5, 2, 1, 0^{2,6}] デカン-3 -オン、8-アクリロイルオキシ-8-エチル-4-オ キサトリシクロ [5. 2. 1. 0^{2.6}] デカン-3-オ トリシクロ[5.2.1.04.6] デカン-3-オン、 8-アクリロイルオキシ-1-エチル-4-オキサトリ シクロ[5.2.1.0².⁶] デカン-3-オン、8-アクリロイルオキシー10-エチルー4-オキサトリシ クロ[5.2.1.0^{2.6}] デカン-3-オン、9-ア クリロイルオキシー7-エチル-4-オキサトリシクロ [5.2.1.01.6] デカン-3-オン、9-アクリ ロイルオキシー8-エチル-4-オキサトリシクロ [5.2.1.0^{2.6}] デカン-3-オン、9-アクリ ロイルオキシー9ーエチルー4ーオキサトリシクロ [5.2.1.01.6] デカン-3-オン、9-アクリ ロイルオキシー1ーエチルー4ーオキサトリシクロ [5.2.1.01.6] デカン-3-オン、および、9 -アクリロイルオキシ-10-エチル-4-オキサトリ シクロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オン、なら びに、これらの混合物、

【0044】8-アクリロイルオキシ-4,10-ジオ キサトリシクロ [5. 2. 1. 0^{2,6}] デカン-3-オ ン、および、9-アクリロイルオキシ-4、10~ジオ 【0041】8-アクリロイルオキシ-7-メチル-4 30 キサトリシクロ [5.2.1.0^{2.6}] デカン-3-オ ン、ならびに、これらの混合物、

> 【0045】8-アクリロイルオキシ-1-メチル-4, 10-ジオキサトリシクロ [5, 2, 1, 02,6] デカン-3-オン、8-アクリロイルオキシ-7-メチ ル-4, 10-ジオキサトリシクロ[5, 2, 1, 0 ² ⁸] デカン-3-オン、9-アクリロイルオキシ-1 ーメチルー4, 10ージオキサトリシクロ[5.2. 1.02.6] デカン-3-オン、および、9-アクリロ イルオキシー7-メチルー4、10-ジオキサトリシク に、これらの混合物、

【0046】7-メタクリロイルオキシ-3-オキサビ シクロ[4.3.0]ノナン-2-オン、および、8-メタクリロイルオキシー3-オキサビシクロ「4.3. 0] ノナン-2-オン、ならびに、これらの混合物、 【0047】7-メタクリロイルオキシ-7-メチルー 3-オキサビシクロ[4.3.0]ノナン-2-オン、 7-メタクリロイルオキシ-8-メチル-3-オキサビ シクロ[4.3.0]ノナン-2-オン、8-メタクリ 50 ロイルオキシー 7 - メチルー3 - オキサビシクロ「4.

3.0] ノナン-2-オン、および、8-メタクリロイ ルオキシー8-メチル-3-オキサビシクロ[4.3. 0] ノナン-2-オン、ならびに、これらの混合物、 【0048】7-メタクリロイルオキシー6-メチルー 3-オキサビシクロ[4.3.0]ノナン-2-オン、 7-メタクリロイルオキシ-9-メチル-3-オキサビ シクロ[4.3.0]ノナン-2-オン、8-メタクリ ロイルオキシー6-メチルー3-オキサビシクロ「4. 3.0] ノナン-2-オン、および、8-メタクリロイ ルオキシ-9-メチル-3-オキサビシクロ[4.3. 0] ノナン-2-オン、ならびに、これらの混合物、 【0049】7、8-ジメチル-7-メタクリロイルオ キシ-3-オキサビシクロ[4.3.0] ノナン-2-オン、および、7、8-ジメチル-8-メタクリロイル オキシー3-オキサビシクロ[4.3.0]ノナン-2 -オン、ならびに、これらの混合物、

【0050】8-メタクリロイルオキシー4-オキサト リシクロ[5.2.1.01.6] デカン-3-オン、お よび、9-メタクリロイルオキシ-4-オキサトリシク ロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オン、ならび に、これらの混合物、

【0051】8-メタクリロイルオキシ-7-メチル-4-オキサトリシクロ [5.2.1.0².6] デカン-3-オン、8-メタクリロイルオキシ-8-メチル-4 -オキサトリシクロ[5, 2, 1, 0².6] デカン-3 ーオン、8-メタクリロイルオキシ-9-メチル-4-オキサトリシクロ[5.2.1.03.6] デカン-3-オン、8-メタクリロイルオキシ-1-メチル-4-オ キサトリシクロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オ ン、8-メタクリロイルオキシー $1\cdot 0$ - メチルー4 - オ 30 $\cdot 1$ $\cdot 0$ $^{2\cdot 6}$] デカンー3 - オン、および、9 - メタクリ キサトリシクロ [5.2.1.02.6] デカン-3-オ ン、9-メタクリロイルオキシ-7-メチル-4-オキ サトリシクロ $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$ デカン-3-オン、9-メタクリロイルオキシ-8-メチル-4-オキ サトリシクロ[5, 2, 1, 02.6] デカン-3-オ ン、9-メタクリロイルオキシ-9-メチル-4-オキ サトリシクロ[5.2.1.01.6] デカン-3-オ ン、9-メタクリロイルオキシ-1-メチル-4-オキ サトリシクロ[5.2.1.016] デカン-3-オ ン、および、9-メタクリロイルオキシ-10-メチル 40 -4-オキサトリシクロ[5.2.1.0².⁶] デカン -3-オン、ならびに、これらの混合物、

【0052】8-メタクリロイルオキシ-7-エチルー 4-オキサトリシクロ[5.2.1.02.6] デカンー 3-オン、8-メタクリロイルオキシ-8-エチル-4 -オキサトリシクロ[5.2.1.0^{2,6}] デカン-3 -オン、8-メタクリロイルオキシ-9-エチル-4-オキサトリシクロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オン、8-メタクリロイルオキシ-1-エチル-4-オ キサトリシクロ[5.2.1.01.6] デカンー3ーオ

ン、8-メタクリロイルオキシ-10-エチル-4-オ キサトリシクロ [5.2.1.01.6] デカン-3-オ ン、9-メタクリロイルオキシ-7-エチル-4-オキ サトリシクロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オ ン、9-メタクリロイルオキシ-8-エチル-4-オキ サトリシクロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オ ン、9-メタクリロイルオキシ-9-エチル-4-オキ サトリシクロ[5.2.1,02.6]デカン-3-オ ン、9-メタクリロイルオキシ-1-エチル-4-オキ 10 サトリシクロ [5.2.1.0*.6] デカン-3-オ ン、および、9-メタクリロイルオキシ-10-エチル -4-オキサトリシクロ[5.2.1.02.6] デカン -3-オン、ならびに、これらの混合物、

【0053】8-メタクリロイルオキシ-4-オキサト リシクロ[5.2.2.016] ウンデカン-3-オ ン、および、9-メタクリロイルオキシー4-オキサト リシクロ[5.2.2.016]ウンデカン-3-オ ン、ならびに、これらの混合物、

【0054】8-メタクリロイルオキシ-4,10-ジ 20 オキサトリシクロ [5.2.1.02.6] デカン-3-オン、および、9-メタクリロイルオキシ-4,10-ジオキサトリシクロ[5.2.1.02.6] デカン-3 - オン、ならびに、これらの混合物、

【0055】8-メタクリロイルオキシ-1-メチル-4, 10-ジオキサトリシクロ[5.2,1.02.8] デカン-3-オン、8-メタクリロイルオキシ-7-メ チルー4, 10-ジオキサトリシクロ[5.2.1.0 ².⁶] デカン-3-オン、9-メタクリロイルオキシー 1-メチル-4, 10-ジオキサトリシクロ[5.2. ロイルオキシー7-メチル-4,10-ジオキサトリシ クロ [5.2.1.0^{2.6}] デカン-3-オン、ならび に、これらの混合物など。

【0056】2. 本発明の重合体に用いる単量体の製造

とのような式(1)で示される単量体は、1,3-ジェ ンと無水マレイン酸とをディールス・アルダー反応させ て得られる付加生成物、例えば、(メチルー) 5-ノル ボルネン-2, 3-ジカルボン酸無水物等を選択的に還 元し、水和して得られたアルコールを (メタ) アクリル エステル化することにより、製造できる。

【0057】1、3-ジエンと無水マレイン酸とのディ ールス・アルダー付加生成物をオレフィンラクトンに還 元する方法は特に限定されないが、通常、還元剤として 水素化ホウ素ナトリウム等の金属水素化物や金属水素錯 化合物をディールス・アルダー付加生成物 1 モルに対し て0.5~1.5モル程度用い、-20~60℃で反応 を行う。溶媒としては、ジグライム、N、N-ジメチル アセトアミド、N-メチルピロリドンを用いることが好 50 ましい。そして、還元反応後、反応液に必要に応じて水

16

を加えた後、塩酸、硫酸または酸性イオン交換樹脂等の酸を加えて中和、好ましくはさらに酸を加えて酸性にし、ラクトン化する。

【0058】得られたラクトンの炭素-炭素二重結合を水和する方法は特に限定されず、例えば、(i) 水ホウ素化後、酸化的加水分解する方法、(ii) トリフルオロメタンスルホン酸等の酸触媒の存在下でギ酸等の低級カルボン酸を付加させて得られるエステルを加水分解する方法、(iii) Tetrahedron, 47,5513(1991)、Liebigs Ann. Chem.,691(1993)のように、ラクトンをアルカリ加水分解後、ヨードラクトン化し、ヨウ素を還元的に除去して再びラクトン化する方法などがある。中でも、(ii) 低級カルボン酸を用いる方法が好ましい。

【0059】このようにして得られたアルコールを(メタ)アクリルエステル化して、上記式(1)で示される単量体を得る。(メタ)アクリルエステル化の方法としては、例えば、(メタ)アクリル酸ハライド、(メタ)アクリル酸無水物、(メタ)アクリル酸、または、(メタ)アクリル酸エステルとアルコールとを反応させてエステル化する方法が挙げられる。

【0060】3. 本発明の重合体

上記式(1)で示される単量体を含むモノマー組成物を (共)重合して得られる本発明の重合体は、例えば、レ ジスト組成物用、特に化学増幅型レジスト組成物用に好 適である。以下、本発明の重合体が化学増幅型レジスト 組成物用樹脂である場合について説明する。

【0061】化学増幅型レジスト組成物用樹脂には、酸によりアルカリ水溶液に可溶となる性質と、ドライエッチング耐性とが要求される。上記式(1)で示される単量体の単独重合体、あるいは、2種以上の上記式(1)で示される単量体の共重合体は、酸によりアルカリ水溶液に可溶となる性質と高いドライエッチング耐性とを有し、さらには優れた有機溶媒に対する溶解性をも有する。また、このような重合体に、酸の作用で脱離しやすい官能基を有する構造や、環状炭化水素基等の高いドライエッチング耐性を有する構造を導入してもよい。

【0062】酸の作用で脱離しやすい官能基を有する構造としては、例えば、アセチル基、 t ープチル基、テトラヒドロビラニル基、メチルアダマンチル基、エチルアダマンチル基等によりヒドロキシ基やカルボキシ基を保 40 護した構造が挙げられる。

【0063】酸の作用で脱離しやすい官能基を有する構造、または、高いドライエッチング耐性を有する構造を導入するためには、上記式(1)で示される単量体と、このような構造を有する単量体とを共重合すればよい。【0064】このような構造を有する単量体としては、例えば、これまで化学増幅型レジスト組成物用樹脂の原料単量体として知られているものが使用可能である。本発明の重合体に用いる原料単量体は、リソグラフィーに使用される光源によって任意に選択される。

【0065】例えば、KrFエキシマレーザーや電子線を光源とする場合は、その高いエッチング耐性を考慮して、上記式(1)で示される単量体とp-ヒドロキシスチレンあるいはその誘導体とを共重合した重合体が好適に用いられる。この場合、重合体中の上記式(1)で示される単量体に由来する構成単位の比率は、1%以上であることが好ましく、また、25%以下であることが好ましい。

【0066】ArFエキシマレーザーを光源とする場合は、上記式(1)で示される単量体と環状炭化水素基を有する単量体とを共重合した重合体が好適である。環状炭化水素基を有する単量体を共重合することにより、高い光線透過率、高いエッチング耐性が得られる。

【0067】中でも、上記式(1)で示される単量体と 環状炭化水素基を有する単量体と親水性官能基を有する 単量体とを共重合して得られるアクリル系共重合体、上 記式(1)で示される単量体と環状炭化水素基を有する 単量体と無水マレイン酸とを共重合して得られるアクリ ル系共重合体、または、上記式(1)で示される単量体 と環状炭化水素基を有する単量体とアーブチロラクトン 構造等のラクトン構造を有する単量体とを共重合して得 られるアクリル系共重合体が好適である。環状炭化水素 基を有する単量体と親水性官能基を有する単量体とを共 重合して得られるアクリル系共重合体、環状炭化水素基 を有する単量体と無水マレイン酸とを共重合して得られ るアクリル系共重合体、または、環状炭化水素基を有す る単量体とラクトン構造を有する単量体とを共重合して 得られるアクリル系共重合体は、AFFエキシマレーザ ーリソグラフィー用樹脂として好適であることが知られ ている。このような重合体に上記式(1)で示される単 量体単位を導入することにより、ドライエッチング耐性 が向上し、ドライエッチング後のレジスト表面荒れの少 ない、優れたレジストパターンが得られる。

【0068】環状炭化水素基を有する単量体単位は、これを含む重合体に高いドライエッチング耐性を付与するものである。特に、酸により脱離する保護基(環状炭化水素基が直接保護基になっていてもよい。)を含有するものは、波長193nmのArFエキシマレーザーを用いたフォトリソグラフィーにおける高い感度も付与することができる。環状炭化水素基を有する単量体単位は、必要に応じて、1種としても、2種以上としてもよい。【0069】環状炭化水素基を有する単量体単位としては、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、トリシクロデカニル(メタ)アクリレート、シクロベンタジエニル(メタ)アクリレート、および、これらの単量体の環状炭化水素基上にアルキル基、ヒドロキシ基、カルボキシ基等の置換基を有する誘導体が好ましい。

50 【0070】このような単量体単位として、具体的に

(10)

18

は、1-4ソボルニル (メタ) アクリレート、2-(メタ) アクリロイルオキシー2-メチルアダマンタン、2-(メタ) アクリロイルオキシー2-エチルアダマンタン、1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1-メチルエチル) アダマンタン、シクロヘキシル (メタ) アクリレート、アダマンチル (メタ) アクリレート、トリシクロデカニル (メタ) アクリレート、ジシクロペンタジエニル (メタ) アクリレート等が挙げられる。

【0071】親水性官能基を有する単量体単位は、これを含む重合体に基板に対する密着性を付与するものである。特に、酸により脱離する保護基を含有するものは、波長193nmのArFエキシマレーザーを用いたフォトリソグラフィーにおける高い感度も付与することができる。親水性官能基としては、例えば、末端カルボキシ基、末端ヒドロキシ基、アルキル置換エーテル基(好ましくは炭素数4以下のアルキル置換エーテル基)、δーバレロラクトニル基、γ-ブチロラクトニル基等を挙げることができる。なお、上記の親水性官能基には、通常、疎水性に含まれるものもあるが、本発明において必要な親水性が得られればよいので、上記のものが含まれる。親水性官能基を有する単量体単位は、必要に応じて、1種としても、2種以上としてもよい。

【0072】親水性官能基を有する単量体単位としては、(メタ)アクリル酸、末端ヒドロキシ基を有するは、2-(メタ)アクリレート、アルキル置換エーテル基を有する(メタ)アクリレート、δーバレロラクトニル基を有する(メタ)アクリレート、ャーブチロラクトニル基を有する(メタ)アクリレート、および、(メタ)アクリル酸を除くこれらの単量体の親水性官能基上にアルキル基、ヒドロキシ基、カルボキシ基等の置換基を有する誘っる。場体が好ましい。

【0073】 このような単量体単位として、具体的には、(メタ) アクリル酸、(メタ) アクリル酸-2-ヒドロキシエチル、(メタ) アクリル酸-2-ヒドロキシブチ *

*ル、1-(メタ)アクリロイルオキシ-3-ヒドロキシアダマンタン、(メタ)アクリル酸-2-メトキシエチル、(メタ)アクリル酸-2-エトキシエチル、β-(メタ)アクリロイルオキシ-β-メチル-δ-バレロラクトン、β-(メタ)アクリロイルオキシ-γ-ブチロラクトン、β-(メタ)アクリロイルオキシ-β-メチル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシーアクリロイルオキシートン(メタ)アクリレート等が挙げられる。

[0074] 無水マレイン酸単量体単位は、これを含む 重合体に高いドライエッチング耐性、および、基板に対 する密着性を付与するものである。

【0075】ラクトン構造を有する単量体単位は、これを含む重合体に高いドライエッチング耐性、および、基板に対する密着性を付与するものである。ラクトン構造を有する単量体単位は、必要に応じて、1種としても、2種以上としてもよい。

【0076】ラクトン構造を有する単量体単位としては、4~8員環のα-メチレンラクトン、および、そのラクトン環炭素上にアルキル基、ヒドロキシ基、カルボキシ基等の置換基を有する誘導体が好ましい。

【0077】このような単量体単位として、具体的には、2-メチレン-3-プロパノリド、2-メチレン-4-ブタノリド、2-メチレン-4-メチル-4-ブタノリド、2-メチレン-4-エチル-4-ブタノリド、2-メチレン-4、4-ジメチル-4-ブタノリド、2-メチレン-5-ペンタノリド、2-メチレン-6-ヘキサノリド、2-メチレン-7-ヘプタノリド等が挙げられる。

【0078】化学増幅型レジスト組成物用樹脂としては、具体的には、下記の式(2)、式(3)または式(4)で示される重合体が好適である。

[0079]

[化9]

(式(2)中、R¹、R¹、R¹、R¹は水素原子、メチル基またはエチル基、R¹、R¹、R¹は水素原子またはメ

チル基、R[®]は酸により脱離する基を有する環状炭化水 50 素基、R[®]は親水性官能基を有する基または水素原子で

20

ある。A'とA'はともに水素原子であるか、または、A'とA'とで-O-、-CH,-または-CH,CH,-を 形成している。x'、y'、z'はそれぞれ構成単位

(A)、構成単位(B)、構成単位(C)の比率を示 *

*し、x²+y²+z²=1のとき、0 < x²≤1、0≤y² <1、0≤z²<1を満たす任意の数である。) 【0080】

【化10】

(式(3)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 は水素原子、メチル 基またはエチル基、 R^3 、 R^3 は水素原子またはメチル 基、 R^6 は酸により脱離する基を有する環状炭化水素基 である。 A^1 と A^3 はともに水素原子であるか、または、 A^1 と A^3 とで-O-、 $-CH_1-$ または $-CH_1$ CH $_2-$ を形成している。 X^3 、 Y^3 、 Z^3 はそれぞれ構成単位 ※

※ (A)、構成単位 (B)、構成単位 (D) の比率を示し、 $x^3 + y^3 + z^3 = 1$ のとき、 $0 < x^3 \le 1$ 、 $0 \le y^3 < 1$ 、 $0 \le z^3 < 1$ を満たす任意の数である。)

20 [0081]

【化11】

(式 (4) 中、R¹、R²、R³、R⁴、R¹°、R¹¹は水素原子、メチル基またはエチル基、R⁵、R¹は水素原子またはメチル基、R⁵は酸により脱離する基を有する環状炭化水素基である。A¹とA²はともに水素原子であるか、または、A¹とA²とで-O-、 $-CH_2-$ または $-CH_2CH_2-$ を形成している。nは $0\sim$ 4の整数である。x⁴、y⁴、z⁴はそれぞれ構成単位(A)、構成単位(B)、構成単位(E)の比率を示し、x⁴+y⁴+z⁴=1のとき、<math>0< x⁴ ≤ 1、0 ≤ y⁴ < 1、0 ≤ z⁴ < 1 を満たす任意の数である。)

【0082】上記式(2)において、構成単位(B)は環状炭化水素基を有する単量体単位であり、構成単位(C)は親水性官能基を有する単量体単位である。なお、構成単位(C)中のR*が水素原子の場合はカルボキシ基(-COOH)を有するので親水性を示す。【0083】R*としては、シクロヘキシル基、イソボ

ルニル基、アダマンチル基、トリシクロデカニル基、ジシクロベンタジエニル基、または、これらの環状炭化水素基上に置換基を有する環状炭化水素基のいずれか一種以上であることが好ましく、特に2-メチルアダマンチル基であることが好ましい。

40 【0084】R*としては、末端ヒドロキシ基を有する 基、アルキル置換エーテル基を有する基、δ-バレロラ クトニル基、γ-ブチロラクトニル基または水素原子の いずれか一種以上であることが好ましく、特にγ-ブチ ロラクトニル基であることが好ましい。

【 0085 】 x^{2} 、 y^{2} 、 z^{2} は構成単位の比率(共重合組成)を示し、 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=1$ のとき、 $0 < x^{2} \le 1$ 、 $0 \le y^{2} < 1$ 、 $0 \le z^{2} < 1$ を満たす任意の数であるが、好ましくは0. $3 \le x^{2} \le 0$. 6、0. $3 \le y^{2} \le 0$. 6、 $0 \le z^{2} \le 0$. 4 である。このような共重合体 $1 \le 0$ 0 組成とすることで、十分な有機溶媒に対する溶解性を維

(12)

22

持しつつ、ドライエッチング耐性、および、基板に対す る密着性をさらに向上させることができる。

21

【0086】なお、前述の通り、構成単位(A)、

(B)、(C)は全て同じである必要はなく、上記のような一般式で示されるものであれば2種以上が混在していてもよい。また、上記式(2)において、各構成単位は任意のシーケンスを取り得、上記式(2)で示される重合体は、ランダム共重合体であっても、ブロック共重合体であってもよい。

【0087】上記式(3)において、構成単位(B)は 10 環状炭化水素基を有する単量体単位であり、構成単位(D)は無水マレイン酸単量体単位である。

【0088】R⁶としては、シクロヘキシル基、イソボルニル基、アダマンチル基、トリシクロデカニル基、ジシクロベンタジエニル基、または、これらの環状炭化水素基上に置換基を有する環状炭化水素基のいずれか一種以上であることが好ましく、特に2-メチルアダマンチル基であることが好ましい。

【0089】 x^3 、 y^3 、 z^3 は構成単位の比率(共重合組成)を示し、 $x^3+y^3+z^3=1$ のとき、 $0 < x^3 \le 1$ 、 $0 \le y^3 < 1$ 、 $0 \le z^3 < 1$ を満たす任意の数であるが、好ましくは0. $3 \le x^3 \le 0$. 6、0. $3 \le y^3 \le 0$. 6、0 $\le z^3 \le 0$. 4 である。このような共重合体組成とすることで、十分な有機溶媒に対する溶解性を維持しつつ、ドライエッチング耐性、および、基板に対する密着性をさらに向上させることができる。

【0090】なお、前述の通り、構成単位(A)、

(B)は全て同じである必要はなく、上記のような一般式で示されるものであれば2種以上が混在していてもよい。また、上記式(3)において、各構成単位は任意の 30シーケンスを取り得、上記式(3)で示される重合体は、ランダム共重合体であっても、ブロック共重合体であってもよい。

【0091】上記式(4)において、構成単位(B)は環状炭化水素基を有する単量体単位であり、構成単位(E)はラクトン構造を有する単量体単位である。

【0092】R°としては、シクロヘキシル基、イソボルニル基、アダマンチル基、トリシクロデカニル基、ジシクロベンタジエニル基、または、これらの環状炭化水素基上に置換基を有する環状炭化水素基のいずれか一種 40以上であることが好ましく、特に2-メチルアダマンチル基であることが好ましい。

【0093】R¹⁰、R¹¹としては、水素原子またはメチル基であることが好ましく、特にメチル基であることが好ましい。

【0094】nは0、1または2が好ましい。

【0095】 x^4 、 y^4 、 z^4 は構成単位の比率(共重合組成)を示し、 $x^4+y^4+z^4=1$ のとき、 $0 < x^4 \le 1$ 、 $0 \le y^4 < 1$ 、 $0 \le z^4 < 1$ を満たす任意の数であるが、好ましくは0.3 $\le x^4 \le 0$.6、0.3 $\le y^4 \le$

0.6、0≦z⁴≦0.4である。このような共重合体 組成とすることで、十分な有機溶媒に対する溶解性を維 持しつつ、ドライエッチング耐性、および、基板に対す る密着性をさらに向上させることができる。

【0096】なお、前述の通り、構成単位(A)、

(B)、(E)は全て同じである必要はなく、上記のような一般式で示されるものであれば2種以上が混在していてもよい。また、上記式(4)において、各構成単位は任意のシーケンスを取り得、上記式(4)で示される重合体は、ランダム共重合体であっても、ブロック共重合体であってもよい。

【0097】化学増幅型レジスト組成物用樹脂として用いる場合、上記式(2)、式(3)または式(4)で示される重合体を始めとする本発明の重合体の質量平均分子量は特に限定されないが、1,000以上であることが好ましく、また、100,000以下であることが好ましい。質量平均分子量が大きいほどドライエッチング耐性が向上してレジスト形状がよくなる傾向があり、また、質量平均分子量が小さいほどレジスト溶液に対する溶解性が向上して解像度が向上する傾向がある。

【0098】なお、上記式(2)、式(3)または式(4)で示される重合体を始めとする本発明の重合体は、共重合体の場合、ランダム共重合体であっても、交互共重合体であっても、ブロック共重合体であってもよい。

【0099】4. 本発明の重合体の製造方法

本発明の重合体(化学増幅型レジスト組成物用樹脂)は 公知の重合法により製造することができるが、簡便に製 造できるという点で、あらかじめ単量体および重合開始 剤を有機溶剤に溶解させた単量体溶液を一定温度に保持 した有機溶剤中に滴下する、いわゆる滴下重合法により 製造することが好ましい。

【0100】滴下重合法に用いられる有機溶剤としては特に限定されないが、単量体および得られる共重合体のいずれも溶解できる溶剤が好ましく、例えば、1,4ージオキサン、イソプロピルアルコール、アセトン、テトラヒドロフラン、乳酸エチル等が挙げられる。なお、有機溶剤の使用量は特に限定されず、適宜決めればよい。【0101】滴下重合法に用いられる重合開始剤としては特に限定されないが、例えば、アゾビスイソブチロニトリル、2,2'ーアゾビス(2,4ージメチルバレロニトリル)等のアゾ化合物、過酸化ベンゾイル等の有機過酸化物等が挙げられる。また、nーブチルメルカプタン、nーオクチルメルカプタン等のメルカプタン類を連鎖移動剤として用いてもよい。なお、重合開始剤および連鎖移動剤の使用量は特に限定されず、適宜決めればよい。

【0102】滴下重合法における重合温度は特に限定はされないが、通常、50~150℃の範囲であることが50 好ましい。滴下時間は特に限定されないが、通常、6時

間以上であることが好ましい。また、さらに滴下終了後 1~3時間程度その温度を保持し、重合を完結させると

23

とが好ましい。

【0103】滴下重合法によって製造された重合体溶液 は、必要に応じてテトラヒドロフラン、1,4-ジオキ サン等の良溶媒で適当な溶液粘度に希釈した後、ヘブタ ン、メタノール、水等の多量の貧溶媒中に滴下して重合 体を析出させる。その後、その析出物を濾別し、十分に 乾燥して本発明の重合体を得る。

【0104】重合溶液を多量の貧溶媒中に滴下して重合 10 体を析出させる工程は再沈殿と呼ばれ、重合溶液中に残 存する未反応の単量体や重合開始剤等を取り除くために 非常に有効である。これらの未反応物等は、そのまま残 存しているとレジスト性能に悪影響を及ぼす可能性があ るため、できれば取り除くことが好ましい。この再沈殿 工程は、場合により不要となることもある。

【0105】5. 本発明の化学増幅型レジスト組成物 本発明の化学増幅型レジスト組成物は、上記のような本 発明の重合体および光酸発生剤を溶剤に溶解したもので ある。本発明の重合体は、1種を用いても、2種以上を 20 併用してもよい。

【0106】化学増幅型レジスト組成物(溶剤を除く) 中の本発明の重合体の含有量は、合計で、70質量%以 上であることが好ましい。また、化学増幅型レジスト組 成物(溶剤を除く)中の本発明の重合体の含有量は、合 計で、99.8質量%以下であることが好ましい。

【0107】本発明の化学増幅型レジスト組成物に用い る光酸発生剤は、化学増幅型レジスト組成物の酸発生剤 として使用可能なものの中から任意に選択することがで きる。光酸発生剤は、1種を用いても、2種以上を併用 30 してもよい。

【0108】光酸発生剤としては、例えば、オニウム塩 化合物、スルホンイミド化合物、スルホン化合物、スル ホン酸エステル化合物、キノンジアジド化合物、ジアゾ メタン化合物等が挙げられる。中でも、スルホニウム 塩、ヨードニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム 塩、ビリジニウム塩等のオニウム塩化合物を用いること が好ましい。

【0109】光酸発生剤として、具体的には、トリフェ ニルスルホニウムトリフレート、トリフェニルスルホニ 40 ウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスル ホニウムナフタレンスルホネート、(ヒドロキシフェニ ル) ベンジルメチルスルホニウムトルエンスルホネー ト、ジフェニルヨードニウムトリフレート、ジフェニル ヨードニウムピレンスルホネート、ジフェニルヨードニ ウムドデシルベンゼンスルホネート、ジフェニルヨード ニウムヘキサフルオロアンチモネート等が挙げられる。 【0110】光酸発生剤の使用量は、用いる光酸発生剤 の種類等により適宜決められるが、通常、レジスト用重

量部以上であり、0.5質量部以上であることがより好 ましい。光酸発生剤の使用量をこの範囲にすることによ り、露光により発生した酸の触媒作用による化学反応を 十分に生起させることができる。また、光酸発生剤の使 用量は、通常、レジスト用重合体(本発明の重合体)1 00質量部に対して20質量部以下であり、10質量部 以下であることがより好ましい。光酸発生剤の使用量を この範囲にすることにより、レジスト組成物の安定性が 向上し、組成物を塗布する際の塗布むらや現像時のスカ ム等の発生が十分に少なくなる。

【0111】本発明の化学増幅型レジスト組成物に用い る溶剤は目的に応じて任意に選択されるが、溶剤の選択 は樹脂の溶解性以外の理由、例えば、塗膜の均一性、外 観あるいは安全性等からも制約を受けることがある。

【0112】本発明において通常使用される溶剤として は、例えば、2-ペンタノン、2-ヘキサノン等の直鎖 状ケトン類、シクロペンタノン、シクロヘキサノン等の 環状ケトン類、プロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキルア セテート類、エチレングリコールモノメチルエーテルア セテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセ テート等のエチレングリコールモノアルキルエーテルア セテート類、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等のプロ ピレングリコールモノアルキルエーテル類、エチレング リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ エチルエーテル等のエチレングリコールモノアルキルエ ーテル類、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジ エチレングリコールジエチルエーテル等のジェチレング リコールアルキルエーテル類、酢酸エチル、乳酸エチル 等のエステル類、シクロヘキサノール、1-オクタノー ル等のアルコール類、炭酸エチレン、ィーブチロラクト ン等が挙げられる。これらの溶剤は、1種を用いても、 2種以上を併用してもよい。

【0113】溶剤の使用量は、形成させるレジスト膜の 厚みにもよるので一概に言えないが、通常、レジスト用 重合体(本発明の重合体)100質量部に対して100 質量部以上である。また、溶剤の使用量は、通常、レジ スト用重合体(本発明の重合体)100質量部に対して 10000質量部以下である。

【0114】さらに、本発明の化学増幅型レジスト組成 物には、必要に応じて、界面活性剤、クエンチャー、増 感剤、ハレーション防止剤、保存安定剤、消泡剤等の各 種添加剤を配合することもできる。これらの添加剤の配 合量は特に限定されず、適宜決めればよい。

【0115】界面活性剤としては、例えば、ポリオキシ エチレンラウリルエーテル、ポリエチレングリコールジ ラウレート等のノニオン系界面活性剤の他、以下、商品 合体(本発明の重合体)100質量部に対して0.1質 50 名でポリフローNo.75(共栄社油脂化学工業社

製)、メガファックスF173 (大日本インキ化学工業 社製)、サーフロンSC-105 (旭硝子社製)、L-70001 (信越化学社製)等が挙げられる。

【0116】6. 本発明のパターン形成方法 次に、本発明のパターン形成方法の一例について説明す る。

【0117】最初に、パターンを形成するシリコンウェ ハー等の被加工基板の表面に、本発明の化学増幅型レジ スト組成物をスピンコート等により塗布する。そして、 との化学増幅型レジスト組成物が塗布された被加工基板 10 ·は、ベーキング処理 (プリベーク) 等で乾燥し、基板上 にレジスト膜を形成する。

【0118】次いで、このようにして得られたレジスト 膜に、フォトマスクを介して、250nm以下の波長の 光を照射する(露光)。露光に用いる光は、220nm 以下の波長の光、特にArFエキシマレーザーであるこ とが好ましい。

【0119】光照射(露光)後、適宜ベーキング処理 (PEB) し、基板をアルカリ現像液に浸漬し、露光部 分を現像液に溶解除去する(現像)。アルカリ現像液は 20 公知のものいずれを用いてもよい。そして、現像後、基 板を純水等で適宜リンス処理する。このようにして被加 工基板上にレジストパターンが形成される。

【0120】通常、レジストパターンが形成された被加 工基板は、適宜ベーキング処理(ポストベーク)してレ ジストを強化し、レジストのない部分を選択的にエッチ ングする。エッチングを行った後、レジストは、通常、 剥離剤を用いて除去される。

[0121]

【実施例】以下、本発明を実施例によって詳しく説明す 30 るが、本発明はこれらに限定されるものではない。ま た、ここで「部」とは、特に断りがない限り「質量部」 を意味する。

【0122】また、製造した共重合体の物性測定は以下 の方法で行った。

【0123】<質量平均分子量>ゲル・パーミッション ・クロマトグラフィー(以下、GPCという。) によ り、ポリメタクリル酸メチル換算で求めた。溶剤には、 クロロホルムあるいはテトラヒドロフランを使用した。 1H-NMRの測定により求めた。溶剤には、重クロロ ホルムあるいは重アセトンを使用した。

【0125】[製造例1] 8-メタクリロキシ-4-オキサトリシクロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オンと9-メタクリロキシ-4-オキサトリシクロ [5.2.1.01.6] デカン-3-オンの混合物の製 造例

白色固体の5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸無 水物(和光純薬工業社製)82.1g(0.5mol) をN、N-ジメチルアセトアミド600m1に溶解し、

攪拌機、温度計を備えたフラスコに入れ、氷水浴で0~ 10℃に冷却した。温度が40℃以上にならないよう注 意しながら、これに水素化ホウ素ナトリウム21.0g (O.5mol)を少しずつ加え、12時間攪拌した。 攪拌終了後、中和熱、発泡に注意しながら、6規定塩酸 をpH2になるまで加え、6時間放置した。そして、反 応液をトルエンで抽出後、有機層を合わせて水で洗浄し て硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去したところ、白 色固体の4-オキサトリシクロ[5.2.1.02.6] $-8 - \mathcal{F} + 2 - 3 - 4 + 2 - 5 = 7$. 3g(0.38mol)収率76%)を得た。

【0126】次いで、攪拌機、温度計、コンデンサーを 備えたフラスコにギ酸71.7g(1.56mol)、 4-オキサトリシクロ[5.2.1.02.6]-8-デ セン-3-オン52.6g(0.35mol)を入れ、 発熱に注意しながらトリフルオロメタンスルホン酸5. 3g(0,035mol)を少しずつ加えた。そして、 100℃で6時間反応した後、反応液を酢酸エチルで抽 出し、有機層を合わせて水、飽和重曹水で洗浄した。洗 浄後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去して、未精 製の8-ホルミルー4-オキサトリシクロ〔5.2. 1.02.6] デカン-3-オンと9-ホルミル-4-オ キサトリシクロ [5. 2. 1. 0^{2.6}] デカン-3-オ ンの混合物を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグ ラフィーで精製し、透明な液体の8-ホルミル-4-オ キサトリシクロ [5.2.1.0^{2.6}] デカン-3-オ ンと9-ホルミルー4-オキサトリシクロ「5、2、 1.04.6] デカン-3-オンの混合物38.1g (0.19mol、収率55%)を得た。

【0127】次いで、攪拌機、温度計、コンデンサーを 備えたフラスコに8-ホルミル-4-オキサトリシクロ [5.2.1.01,6] デカン-3-オンと9-ホルミ ルー4ーオキサトリシクロ[5.2.1.02.6] デカ ン-3-オンの混合物35.3g(0.18mol)、 メタノール100mlを入れた。これに10%水酸化カ リウム水溶液100gを加え、室温で12時間攪拌して メタノールを留去した。残さを酢酸エチルで抽出し、有 機層を合わせて水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥 し、溶媒を留去して、未精製の8-ヒドロキシ-4-オ 【0124】<共重合体の平均共重合組成(モル%)> 40 キサトリシクロ[5.2.1.02.6]デカン-3-オ ンと9-ヒドロキシ-4-オキサトリシクロ[5.2. 1.02.6] デカン-3-オンの混合物を得た。これを シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、透明な 液体の8-ヒドロキシー4-オキサトリシクロ[5. 2. 1. 0*.6] デカン-3-オンと9-ヒドロキシー 4-オキサトリシクロ[5.2.1.01.6] デカンー 3-オンの混合物26.1g(0.16mo1、収率8 6%)を得た。

> 【0128】次いで、攪拌機、2つの滴下ロート、温度 50 計、コンデンサーを備えたフラスコに、8-ヒドロキシ

(15)

-4-オキサトリシクロ[5.2.1.0^{2.6}] デカン -3-オンと9-ヒドロキシ-4-オキサトリシクロ [5.2.1.03.6] デカン-3-オンの混合物1 6.8g(0.10mol)、乾燥ジクロロメタン80 m1を入れた。滴下ロートの一方にはトリエチルアミン 13.2g(0.13mol)を、もう一方にはメタク リル酸クロリド12.5g(0.12mol)を仕込 み、フラスコの内部を窒素置換した。そして、フラスコ 内を攪拌しながら、トリエチルアミンとメタクリル酸ク ロリドを、メタクリル酸クロリドに対してトリエチルア 10 ミンが小過剰になるように調整しながら、1時間かけて 滴下した。この時、わずかな発熱が観察された。滴下終 了後、ジメチルアミノピリジン0.3g(0.002m o 1)を加えて24時間攪拌を続けた。そして、反応液 に注意深くメタノール100m1を加え、水、飽和重曹 水で順次洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒 を留去して未精製の8-メタクリロキシ-4-オキサト リシクロ[5.2.1.02.6] デカン-3-オンと9 ーメタクリロキシー4ーオキサトリシクロ[5.2. 1.0^{2.6}] デカン-3-オンの混合物を得た。これを シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、透明な 液体の8-メタクリロキシ-4-オキサトリシクロ [5.2.1.0².6] デカン-3-オンと9-メタク リロキシー4ーオキサトリシクロ[5.2.1. 0². ⁶] デカン-3-オンの混合物(以下、OTDMA という。) 15. 0g (0. 063mo1、収率63 %)を得た。

【0129】 [製造例2] 8-アクリロキシー4-オ キサトリシクロ [5.2.1.0^{2.6}] デカン-3-オ ンと9-アクリロキシ-4-オキサトリシクロ [5. 2. 1. 0 * . * 〕 デカン-3-オンの混合物の製造例 攪拌機、2つの滴下ロート、温度計、ジムロート冷却管 を備えたガラスフラスコに、製造例1の方法と同様にし*

* て製造した8-ヒドロキシ-4-オキサトリシクロ [5.2.1.04.6] デカン-3-オンと9-ヒドロ キシ-4-オキサトリシクロ[5, 2, 1, 0² ⁶] デ カン-3-オンの混合物8.4g(0.05mol)、 乾燥ジクロロメタン40mlを入れた。滴下ロートの一 方にはトリエチルアミン6.6g(0.065mol) を、もう一方にはアクリル酸クロリド5.4g(0.0 6 m o 1)を仕込み、フラスコの内部を窒素置換した。 そして、フラスコ内を攪拌しながら、トリエチルアミン とアクリル酸クロリドを、アクリル酸クロリドに対して トリエチルアミンが小過剰になるように調整しながら1 時間かけて滴下した。との時、わずかな発熱が観察され た。滴下終了後、ジメチルアミノピリジン0.1g (0.001mol)を加えて24時間攪拌を続けた。 そして、反応液に注意深くメタノール35m1を加え、 水、飽和重曹水で順次洗浄した後、硫酸マグネシウムで 乾燥し、溶媒を留去して、未精製の8-アクリロキシー 4-オキサトリシクロ[5.2.1.02.6] デカンー 3-オンと9-アクリロキシ-4-オキサトリシクロ [5.2.1.0^{1.6}] デカン-3-オンの混合物を得 た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製 し、8-アクリロキシ-4-オキサトリシクロ「5. 2. 1. 0 * . * 〕 デカン - 3 - オンと 9 - アクリロキシ -4-オキサトリシクロ[5.2.1.0^{2.6}] デカン - 3 - オンの混合物(以下、OTDAという。) 9.3 g(0.042mol、収率84%)を得た。 【0130】 [実施例1] 下記の式(5)で示される 重合体(上記式(2)における、R'およびR'がメチル 基、R¹~R⁴が水素原子、R⁶が2-メチル-2-アダ 30 マンチル基、 A^1 、 $A^2 = -CH_2 - x^2 = 0.5 x^2$ =0.5、z²=0)の製造 [0131] 【化12】

【0132】窒素導入口、攪拌機、コンデンサーおよび 温度計を備えたセパラブルフラスコに、窒素雰囲気下で 乳酸エチル30.0部を入れ、攪拌しながら湯浴の温度 を80℃に上げた。OTDMA13.33部、2-メタ クリロイルオキシ-2-メチルアダマンタン(以下、M AdMAという。) 13.22部、乳酸エチル30.0 部およびアゾビスイソブチロニトリル0.21部を混合 50 部に攪拌しながら滴下し、得られた沈殿を濾別し、減圧

した単量体溶液を一定速度で6時間かけてフラスコ中に 滴下し、その後、80℃で2時間保持した。次いで、得 られた反応溶液をメタノール800部に攪拌しながら滴 下し、白色の析出物の沈殿を得た。この沈殿を瀘別し、 減圧下60℃で約10時間乾燥した。そして、沈殿をテ トラヒドロフラン45部に溶解させ、メタノール800

(5)

下60℃で約40時間乾燥した。

【0133】各物性を測定したところ、GPC分析によ る質量平均分子量(以下Mwという。)は13900、 分散度(以下、Mw/Mnという。)は1.60で、共 重合比は H-NMRの積分比からOTDMA: MAd MA = 50:50 $cap (x^2 = 0.5)$ $y^2 = 0.$ $5 \cdot z^{2} = 0$).

*【0134】[実施例2] 下記の式(6)で示される 重合体(上記式(2)における、R'~R'、R'が水素 原子、R⁶が2-メチル-2-アダマンチル基、A¹, A $z^2 = -CH_z - x^2 = 0.5, y^2 = 0.5, z^2 = 0$ の製造

30

[0135]

【化13】

$$\begin{array}{c|c}
(CH_2 & 0.5 \\
\hline
0.5 & (CH_2 & 0.5$$

【0136】実施例1のOTDMA13. 33部をOT クリロイルオキシ-2-メチルアダマンタン(以下、M AdAという。) 12. 43部に変更した以外は実施例 1と同様に合成し、共重合体を得た。

【0137】各物性を測定したところ、GPC分析によ るMwは14500、Mw/Mnは1.43で、共重合 比は¹H-NMRの積分比からOTDA: MAdA=5 0:50 $rac{1}{2}$ $rac{1}$ $rac{1}{2}$ $rac{1}$ $rac{1}{2}$ $rac{1}{2}$ $rac{1}$ $rac{1}$

※0)。

DA12.54部に、MAdMA13.22部を2-ア 20 【0138】[実施例3] 下記の式(7)で示される 重合体(上記式(2)における、R'およびR'がメチル 基、R1~R1が水素原子、R1が2-エチル-2-アダ マンチル基、 A^1 , $A^2 = -CH_2 - x^2 = 0.5 x y^2$ = 0.5、z'=0)の製造

> [0139] 【化14】

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_2 & 0.5 \\
\hline
0 & 0 & 0
\end{array}$$
(7)

【0140】実施例1のMAdMA13. 22部を2-メタクリロイルオキシ-2-エチルアダマンタン(以 は実施例1と同様に合成し、共重合体を得た。

【0141】各物性を測定したところ、GPC分析によ るMwは11300、Mw/Mnは1.38で、共重合 比は'H-NMRの積分比からOTDMA: EAdMA =50:50 rbot $(x^2=0.5, y^2=0.5, z)$

'=0)。

【0142】[実施例4] 下記の式(8)で示される 下、EAdMAという。)14.01部に変更した以外 40 重合体(上記式(2)における、R'およびR'がメチル 基、R1~R1が水素原子、R1が2-(1-アダマンチ ル) プロピル基、 A^1 , $A^2 = -CH$, -、 $x^2 = 0$. 5、 y'=0.5、z'=0)の製造

[0143]

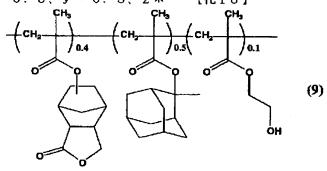
【化15】

【0144】実施例1のMAdMA13. 22部を1-(1-メタクリロイルオキシ-1-メチルエチル)アダ マンタン(以下、IAdMAという。) 14.83部に 変更した以外は実施例1と同様に合成し、共重合体を得 た。

【0145】各物性を測定したところ、GPC分析によ るMwは10700、Mw/Mnは1.45で、共重合 比は'H-NMRの積分比からOTDMA: IAdMA =50:50 rbot $(x^2=0.5, y^2=0.5, z*$ 【0146】 [実施例5] 下記の式(9)で示される 重合体(上記式(2)において、R'、R'、R'がメチ ル基、R¹~R⁴が水素原子、R⁶が2-メチル-2-ア ダマンチル基、R[®]が2-ヒドロキシエチル基、A¹、A $^{2} = -CH_{2} -$, $x^{2} = 0$. 4, $y^{2} = 0$. 5, $z^{2} = 0$. 1)の製造

(8)

[0147] 【化16】



【0148】窒素導入口、攪拌機、コンデンサーおよび 30 温度計を備えたセパラブルフラスコに、窒素雰囲気下で 乳酸エチル30.0部を入れ、攪拌しながら湯浴の温度 を80℃に上げた。OTDMA10.67部、MAdM A13. 22部、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル (以下、HEMAという。) 1. 47部、乳酸エチル3 0. 0部およびアゾピスイソブチロニトリル0. 21部 を混合した単量体溶液を一定速度で6時間かけてフラス コ中に滴下し、その後、80℃で2時間保持した。次い で、得られた反応溶液をメタノール800部に攪拌しな がら滴下し、白色の析出物の沈殿を得た。この沈殿を濾 40 チル基、 A^1 , $A^2 = -CH_2 - x^2 = 0$. $4 \times y^2 = 1$ 別し、減圧下60℃で約10時間乾燥した。そして、沈 殿をテトラヒドロフラン45部に溶解させ、メタノール 800部に攪拌しながら滴下し、得られた沈殿を濾別

し、減圧下60℃で約40時間乾燥した。

【0149】各物性を測定したところ、GPC分析によ るMwは8500、Mw/Mnは1.71で、共重合比 は¹H-NMRの積分比からOTDMA: MAdMA: HEMA = 40:50:10 cb (x'=0.4) $y^2 = 0.5$, $z^2 = 0.1$) 【0150】[実施例6] 下記の式(10)で示され る重合体(上記式(2)において、R'、R'、R"がメ チル基、R1~R1が水素原子、R5が2-メチル-2-アダマンチル基、R[®]が3-ヒドロキシ-1-アダマン 0.5、z²=0.1)の製造 [0151]

【化17】

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 & CH_5 & CH_5 \\
\hline
CH_2 & 0.4 & CH_2 & 0.5 & CH_5 \\
\hline
OH & OH
\end{array}$$
(10)

【0152】実施例5のHEMA1.47部を1-メタクリロイルオキシ-3-ヒドロキシアダマンタン(以下、HAdMAという。)2.67部に変更した以外は実施例5と同様に合成し、共重合体を得た。

【0153】各物性を測定したところ、GPC分析によるMwは12400、Mw/Mnは1.61で、共重合比は 1 H-NMRの積分比からOTDMA: MAdMA: HAdMA=40:50:10であった(\mathbf{x}^2 =0.4、 \mathbf{y}^2 =0.5、 \mathbf{z}^2 =0.1)。

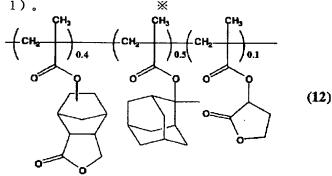
*【0154】[実施例7] 下記の式(11)で示される重合体(上記式(2)において、R⁵、R⁷、R⁹がメチル基、R¹~R⁴が水素原子、R⁶が2ーメチルー2ーアダマンチル基、R⁸が3ー(4ーブタノリド)基、A¹、A²=-CH₂-、x²=0.4、y²=0.5、z²=0.1)の製造【0155】 【化18】

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 & CH_3 \\
\hline
CH_2 & 0.5 & CH_2 \\
\hline
0.5 & CH_2 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$
(11)

【0156】実施例5のHEMA1.47部をβ-メタクリロイルオキシーィーブチロラクトン(以下、HGB MAという。)1.92部に変更した以外は実施例5と同様に合成し、共重合体を得た。

【0157】各物性を測定したところ、GPC分析によるMwは9600、Mw/Mnは1.64で、共重合比は 1 H-NMRの積分比からOTDMA:MAdMA:HGBMA=40:50:10であった(x^{2} =0.4、 y^{2} =0.5、 z^{2} =0.1)。

30%【0158】[実施例8] 下記の式(12)で示される重合体(上記式(2)において、R⁵、R⁷、R⁹がメチル基、R¹~R⁴が水素原子、R⁶が2ーメチルー2ーアダマンチル基、R⁸が2ー(4ープタノリド)基、A¹、A²=-CH₂-、x²=0.4、y²=0.5、z²=0.1)の製造【0159】 【化19】



【0160】実施例5のHEMA1.47部を $\alpha-$ メタ MAという。)1.92部に変更した以外は実施例5とクリロイルオキシー $\gamma-$ ブチロラクトン(以下、GBL 50 同様に合成し、共重合体を得た。

【0161】各物性を測定したところ、GPC分析によ るMwは8200、Mw/Mnは1.52で、共重合比 は H-NMRの積分比からOTDMA: MAdMA: GBLMA=40:50:10であった($x^2=0$. $4 \cdot y^2 = 0 \cdot 5 \cdot z^2 = 0 \cdot 1)$.

35

【0162】 [実施例9] 下記の式(13)で示され*

* る重合体(上記式(2)において、R'、R'、R'がメ チル基、R¹~R¹、R゚が水素原子、R゚が2-メチルー 2-rダマンチル基、 A^1 , $A^2=-CH$, -、 $x^2=0$. 4、y'=0.5、z'=0.1)の製造 [0163] [化20]

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_2 & 0.4 \\
\hline
0 & 0 & 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
\hline
0.1 & 0.1
\end{array}$$

【0164】実施例5のHEMA1、47部をメタクリ ル酸(以下、MAAという。) 0.97部に変更した以 外は実施例5と同様に合成し、共重合体を得た。

るMwは7300、Mw/Mnは1.77で、共重合比 は H-NMRの積分比からOTDMA: MAdMA: MAA = 40:50:10であった ($x^2 = 0.4$, y^2 $= 0.5, z^2 = 0.1)$

※【0166】[実施例10] 下記の式(14)で示さ れる重合体(上記式(3)において、R'、R'がメチル 基、R¹~R⁴が水素原子、R⁶が2-メチル-2-アダ 【0165】各物性を測定したところ、GPC分析によ 20 マンチル基、A¹, A゚= - C H₂ - 、x゚= 0. 4 、y゚ = 0.5、z³=0.1)の製造 [0167] 【化21】

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 & H & H \\
\hline
CH_2 & 0.4 & CH_2 & 0.5 & 0.1 \\
\hline
0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}$$
(14)

【0168】実施例5のHEMA1. 47部を無水マレ イン酸(以下、MAという。) 1.10部に変更した以 外は実施例5と同様に合成し、共重合体を得た。

【0169】各物性を測定したところ、GPC分析によ るMwは7800、Mw/Mnは1.48で、共重合比 40 4、y'=0.5、z'=0.1)の製造 は H-NMRの積分比からOTDMA: MAdMA: MA = 40:50:10 であった $(x^3 = 0.4, y^3 =$ $0.5, z^3 = 0.1)$

【0170】[実施例11] 下記の式(15)で示さ れる重合体(上記式(4)において、R'~R'、R'が 水素原子、R10、R11がメチル基、R6が2-メチルー 2-アダマンチル基、 A^1 , $A^2=-$ C H_2- 、 $x^4=0$. [0171] 【化22】

【0172】実施例5のOTDMA10.67部をOTDA10.03部に、MAdMA13.22部をMAdA12.43部に、HEMA1.47部を2-メチレン-4,4-ジメチル-4-ブタノリド(以下、MDMBLという。)1.42部に変更した以外は実施例5と同様に合成し、共重合体を得た。

【0173】各物性を測定したところ、GPC分析によるMwは9200、Mw/Mnは1.57で、共重合比は¹H-NMRの積分比からOTDA:MAdA:MD *

* MBL = 40:50:10であった(x⁴=0.4、y⁴=0.5、z⁴=0.1)。

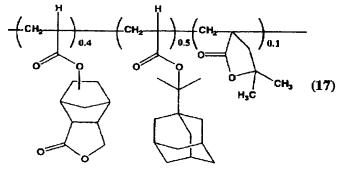
【0174】[実施例12] 下記の式(16)で示される重合体(上記式(4)において、R¹~R⁵、R⁷が水素原子、R¹⁰、R¹¹がメチル基、R⁶が2-エチルー2-アダマンチル基、A¹、A¹=-CH₂-、x¹=0.4、y¹=0.5、z¹=0.1)の製造【0175】 【化23】

【0176】実施例11のMAdA12.43部を2-アクリロイルオキシ-2-エチルアダマンタン(以下、EAdAという。)13.17部に変更した以外は実施例11と同様に合成し、共重合体を得た。

【0177】各物性を測定したところ、GPC分析によるMwは8800、Mw/Mnは1.40で、共重合比は¹H-NMRの積分比からOTDA:EAdA:MDMBL=40:50:10であった(x¹=0.4、y¹※

30% = 0.5, z' = 0.1)

【0178】 [実施例13] 下記の式(17)で示される重合体(上記式(4)において、R¹~R⁵、R⁷が水素原子、R¹⁰、R¹¹がメチル基、R⁶が2-(1-アダマンチル)プロピル基、A¹、A²=-CH₂-、x⁴=0.4、y⁴=0.5、z⁴=0.1)の製造【0179】 【化24】



【 0 1 8 0 】 実施例 1 1 の M A d A 1 2 . 4 3 部を 1 - (1 - アクリロイルオキシ - 1 - メチルエチル) アダマンタン(以下、 I A d A という。) 1 3 . 9 4 部に変更 50

した以外は実施例11と同様に合成し、共重合体を得た。

【0181】各物性を測定したところ、GPC分析によ

るMwは8600、Mw/Mnは1.55で、共重合比 は H-NMRの積分比からOTDA: IAdA: MD MBL=40:50:10 であった ($x^4=0.4$ 、 y^4 $= 0.5, z^{4} = 0.1)$

【0182】 [比較例1] 5-メタクリロイルオキシ -6-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2 -カルボキシリック-6-ラクトンと2-メタクリロイ ルオキシー2ーメチルアダマンタンの共重合体の製造 窒素導入口、攪拌機、コンデンサーおよび温度計を備え たセパラブルフラスコに、窒素雰囲気下でアセトニトリ 10 =50:50であった。 ル30.0部を入れ、攪拌しながら湯浴の温度を80℃ に上げた。これとは別に、5-メタクリロイルオキシー 6-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-カルボキシリック-6-ラクトン26.64部、MAd MA28.08部、乳酸エチル60.0部およびアゾビ スイソプチロニトリル0.86部を混合したところ、5 -メタクリロイルオキシ-6-ヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2-カルボキシリック-6-ラクトンが溶解しなかった。そとで、乳酸エチル60. 0部をアセトニトリル60.0部に代えたところ、均一 20 な溶液となった。この均一溶液を一定速度で6時間かけ てフラスコ中に滴下し、その後、80℃で2時間保持し た。単量体溶液滴下から2時間を経過した時点から、白 色の重合物の沈殿が反応溶液中に観察された。得られた 反応溶液にテトラヒドロフラン45部を加えただけでは 白色の重合物の沈殿が溶解しなかったため、さらに18 00部加えたところ溶解した。この溶液をメタノール4 000部に攪拌しながら滴下し、白色の析出物の沈殿を 得た。得られた沈殿を瀘別し、減圧下60℃で約10時 間乾燥した。乾燥した沈殿をテトラヒドロフラン200 30 0部に溶解し、メタノール5000部に攪拌しながら滴 下し、得られた沈殿を濾別し、減圧下60℃で約40時 間乾燥した。

【0183】各物性を測定したところ、GPC分析によ るMwは9100、Mw/Mnは1.51で、共重合比 は¹H-NMRの積分比から5-メタクリロイルオキシ -6-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2 -カルボキシリック-6-ラクトン: MAdMA=5 0:50であった。

ーィープチロラクトンと2-メタクリロイルオキシー2 - メチルアダマンタンの共重合体の製造

窒素導入口、攪拌機、コンデンサーおよび温度計を備え たセパラブルフラスコに、窒素雰囲気下で1,4-ジオ キサン15.0部を入れ、攪拌しながら湯浴の温度を8 0℃に上げた。HGBMA9. 61部、MAdMA1 3.22部、1,4-ジオキサン30.0部およびアゾ ビスイソブチロニトリル0.21部を混合した単量体溶 液を一定速度で6時間かけてフラスコ中に滴下し、その 液をメタノール800部に攪拌しながら滴下し、白色の 析出物の沈殿を得た。この沈殿を濾別し、減圧下60℃ で約10時間乾燥した。そして、沈殿をテトラヒドロフ ラン45部に溶解させ、メタノール800部に攪拌しな がら滴下し、得られた沈殿を濾別し、減圧下60℃で約 40時間乾燥した。

【0185】各物性を測定したところ、GPC分析によ るMwは11000、Mw/Mnは1.68で、共重合 比は¹H-NMRの積分比からHGBMA: MAdMA

【0186】 [実施例14] 実施例1~13および比較 例1~2で得られた各共重合体100部を乳酸エチル3 00部、および、プロピレングリコールモノメチルエー テルアセテート300部に室温でそれぞれ溶解し、25 質量%溶液の作成を試みた。その結果を表1に示す。

[0187]

【表1】

		プロピレングリコールモノ	
	乳酸エチル	メテルエーテルアセテート	
実施例1	0	0	
実施例2	0	0	
実施例3	0	0	
実施例4	0	0	
実施例5	0	0	
実施例6	0	0	
実施例7	. 0	0	
実施例8	0	0	
実施例9	0	0	
実施例10	0	0	
実施例11	0	0	
実施例12	0	0	
実施例13	0	0	
比較例1	×	×	
比較例2	0	0	

表中の記号の意味は、

: 均一な透明の溶液が得られた、

×:沈殿が析出した、

である。

【0188】 [実施例15] 実施例1~13および比較 【0184】[比較例2] βーメタクリロイルオキシ 40 例1~2で得られた各共重合体100部とトリフェニル スルホニウムトリフレート2部とをプロピレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート500部に室温でそれ ぞれ溶解して均一溶液とした後、テフロン(登録商標) フィルターを用いて濾過し、レジスト組成物溶液を調製 した。そして、調製した各組成物溶液を3インチシリコ ンウエハー上にスピンコートし、ホットプレートを用い て120℃、60秒間プリベークを行い、膜厚0.5μ mの薄膜を形成した。次に、ArFエキシマレーザー露 光機(波長:193nm)を使用して露光し、ホットプ 後、80℃で2時間保持した。次いで、得られた反応溶 50 レートを用いて120℃で60秒間ベークを行った。そ

して、2.38質量%水酸化テトラメチルアンモニウム 水溶液を用いて室温で現像し、純水で洗浄し、乾燥して レジストパターンを形成した。

【0189】得られたレジストパターンの感度、解像 度、ドライエッチング耐性(エッチング速度)および透 過率を以下のようにして測定・評価した。その結果を表 2に示す。

【0190】<感度>ライン・アンド・スペースパター ン (ライン/スペース=1/1)を1/1の線幅に形成 する露光量(m J/c m²)を感度として測定した。 【0191】 <解像度>上記露光量で露光したときに解 像されるレジストパターンの最小寸法 (μm) を解像度 とした。

【0192】<ドライエッチング耐性>シリコンウエハ ー上に形成したレジスト膜をエッチングし、膜厚の減少* * から各レジストのエッチング速度(ノボラック樹脂のエ ッチング速度を1として規格化)を測定した。エッチン グ条件は、東京エレクトロン社製エッチングマシーンを 用い、ガスはC, F, /Ar/O, 混合ガスで、2000 W, 50mTorrで50秒間実施した。

42

【0193】また、エッチング後のレジスト表面を電子 顕微鏡で観察し、レジスト表面に凹凸のないものを 「〇」、凹凸があり荒れているものを「×」として評価 した。

10 【0194】<透過率>シリコンウエハー上に形成した レジスト膜に、紫外可視分光光度計を用いてArFエキ シマレーザーの波長である193nmでの透過率(%/ μm)を測定した。

[0195]

【表2】

	感度	解像度	エッチング	エッチング後	透過率
	(mJ/cm²)	(µm)	速度	の表面荒れ	(%/µm)
実施例1	4.8	0.18	1.03	0	63
実施例2	5.0	0.18	1.05	0	61
実施例3	4.6	0.17	1.03	0	B4
実施例4	4.5	0.17	1.04	0	62
実施例5	4.2	0.17	1.11	0	65
実施例6	4.8	0.17	1.04	0	62
実施例7	4.0	0.17	1.09	0	68
実施例8	4.6	0.18	1.10	0.	66
実施例9	4.7	O.1B	1.15	0	64
実施例10	5.0	0.18	1.13	0	65
実施例11	5.0	0.17	1.05	0	63
実施例12	4.8	0.17	1.04	0	63
実施例13	4.7	0.17	1.04	0	62
比較例1	5.0	0.19	1.05	0	57
比較例2	3.6	0.16	1.26	×	70

【0196】このように本発明の重合体(実施例1~1 3)を用いた化学増幅型レジスト組成物は、一般に使用 されるレジスト溶剤に対する溶解性に優れ、十分な感度 および解像度を備えた上に、優れたドライエッチング耐 性および透過率を有していた。それに対して、比較例1 の重合体は有機溶剤に対する溶解性に劣っており、この 重合体を用いた化学増幅型レジスト組成物は透過率に劣 っていた。また、比較例2の重合体を用いた化学増幅型 40 レジスト組成物は感度およびエッチング耐性に劣ってい

[0197]

【発明の効果】本発明の重合体は、透明性、ドライエッ チング耐性、有機溶媒に対する溶解性に優れており、化 学増幅型レジスト組成物用樹脂として好適である。

【0198】との重合体を用いた本発明の化学増幅型レ ジスト組成物は、透明性が高く、エッチング後のレジス ト表面に荒れがあまり発生せず、ドライエッチング耐性 が良好である。また、この化学増幅型レジスト組成物 は、高い感度および解像度を有している。

【0199】との化学増幅型レジスト組成物を用いた本 発明のパターン形成方法によれば、髙精度の微細なレジ ストパターンを安定して形成することができる。本発明 の重合体を用いた化学増幅型レジスト組成物は、遠紫外 光エキシマレーザーリソグラフィーや電子線リソグラフ ィー、特にArFエキシマレーザーを使用するリソグラ フィーに好適である。

フロントページの続き

(72)発明者 桑野 英昭

神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号 三 菱レイヨン株式会社化成品開発研究所内

(72)発明者 百瀬 陽

神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号 三 菱レイヨン株式会社化成品開発研究所内

F ターム(参考) 2H025 AA00 AA02 AA09 AB16 AC06 AC08 AD03 BE00 BE10 BG00 CB10 CB14 CB41 CB55

4J100 AJ02R AK32R AL08P AL08Q AL08R BA03R BA11P BA11Q BA11R BC09R BC53P BC53Q BC53R DA01 JA38